



مجله سنجش و ايمني پرتو، جلد ٦، شمارهٔ ٤، تابستان ١٣٩٧

بررسی اثر نوع آشکارساز بر برآورد ضرایب انباشت پرتوهای گاما با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو بر اساس کاهش واریانس

هدی علویان و حسین توکلیعنبران*

دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، سمنان، ایران. *سمنان، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده فیزیک و مهندسی هستهای، کدپستی: ۹۵۱۶۱–۹۳۲۹۹ پستالکترونیکی: tavakoli.anbaran@gmail.com

چکیدہ

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر نوع آشکارساز در برآورد ضرایب انباشت پرتوهای گاما است. در این راستا، ضرایب انباشت شار پرتوهای گامای چشمهی نقطهای همسانگرد ⁶⁰0 با انرژی متوسط ۱۸۲۵۳ MeV در عبور از حفاظهای تیتانیوم، روی، تنگستن، و سرب با ضخامتهای مختلف oc ا توسط کد محاسباتی MCNPX مورد بررسی قرار گرفت. شار ذرات از طریق چهار نوع آشکارساز متداول برای اندازه گیری پرتوهای گاما در شبیه سازی برآورد شد: استوانهی بدون ماده، شمارندهی گایگر – مولر، سوسوزن سدیم یدید، و آشکارساز نقطهای. با توجه به ضخامت زیاد مواد، از روش کاهش واریانس پنجرههای وزنی در محاسبات استفاده شد تا علاوه بر کاهش زمان اجرای برنامه دقت نتایج را نیز افزایش دهد. در این پژوهش، وابستگی ضریب انباشت به عدد اتمی ماده، و نوع آشکارساز تعریف شده مورد تائید قرار گرفت و نتایج نشان داد در حالتهای مختلف بررسی شده، مقادیر ضریب انباشت به عدد اتمی ماده، و نوع آشکارساز تعریف شده مورد تائید قرار گرفت و نتایج نشان آشکارسازهای مختلف بررسی شده، مقادیر ضریب انباشت از ۱ تا ٤ متغیر است. با این حال، مسیر تغییرات ضرایب انباشت برای آشکارسازهای مختلف مود. از روش زمان اجرای بر تایج پیشنهاد می شود به منظور افزایش دقت شبیه سازی و کاهش زمان اجرای برنامه از

کلیدواژگان: ضریب انباشت، حفاظ گذاری، اثر آشکارساز، کاهش واریانس، شبیهسازی مونت کارلو.

۱. مقدمه

مهمی در حفاظت در برابر تابش به شمار میرود [۱-۳]. هنگامی که پرتوهای گاما از یک محیط مادی عبور میکنند، احتمال برهمکنش آنها با اتمهای ماده با توجه به ضخامت حفاظگذاری را می توان بررسی کیفی چگونگی تأثیر یک ماده بر رفتار تابشهای گسیل شده از یک چشمه در یک نقطهی خاص دانست [۱]. حفاظگذاری پرتوهای گاما مبحث

ماده X، عدد اتمی آن Z، و انرژی پرتو E تعریف می شود. مهمترین برهم کنش های گاما با ماده عبارت هستند از: اثر فوتوالکتریک، پراکندگی کامپتون، و تولید زوج [٤]. هر یک از این برهم کنش ها، پرتوهای ثانویه ای تولید می کنند که احتمال رسیدن تعداد بیشتر پرتوها به نقطه ی آشکارسازی را افزایش می دهد.

ضریب انباشت، در طول دههی گذشته مهمترین کمیت در مطالعات حفاظ گذاری به حساب می آید [٥] که مطالعهی رفتار تضعیف پرتوها را تسهیل می کند [١]. مفهوم ضریب انباشت برای نخستین بار توسط وایت در ۱۹۵۰ معرفی شد و درستی آن در مطالعات تضعیف پرتوهای گاما که توسط فانو^۲ در ۱۹۵۳ انجام شد مورد تائید قرار گرفت [٦]. در ۱۹۵٤، اولین مجموعه از ضرایب انباشت توسط گلداشتاین و ویلکینز^۳ برای چشمههای نقطهای، همسانگرد، و تک انرژی گاما در برای چشمههای نقطهای، همسانگرد، و تک انرژی گاما در گذشته، مطالعات گستردهای چه از طریق روش های تئوری ار-۱۰] و چه به صورت تجربی [۱۱–۱۲] به محاسبه و بررسی ضرایب انباشت در راستای حفاظ گذاری فوتونها پرداختهاند.

در مطالعهی تجربی ضرایب انباشت مشکلات متعددی وجود دارد که دقت محاسبهی آن را تحت تأثیر قرار میدهد [7]. از این رو، استفاده از روشهای تئوری که مبتنی بر محاسبات و کدهای پیشرفتهی کامپیوتری هستند مورد توجه بسیاری قرار گرفته است [۲]، که از آن میان میتوان به روشهای محاسباتی بر مبنای روابط برژه³ [۱۳]، تیلور⁶ [۱۲]، روش پیشرفت هندسی^۲ (G-P) [۱۹–۱۲]، روش تکرار^۷ [۱۷]،

⁶ Geometric progression Method

و روش مونت کارلو^ [۱۸،۳] اشاره کـرد. شـبیهسـازی مونـت کارلو روشی تئوری است که با در نظر گرفتن ترابرد تک تک ذرات رفتار متوسط آنها را در عبور از ماده مطالعه مي كند [۱]. این روش مانند یک آزمایشگاه مجازی عمل میکند و میتوان در آن کل رخدادها و احتمالات ذرات را در نظر گرفت. به عبارت بهتر، مزیت شبیهسازی مونت کارلو نسبت به روش های محاسباتي توانايي آن در لحاظ کردن پيچيدگيهاي هندسي، و جزئیات چشمه و آشکارساز مورد استفاده است. بنابراین، با استفاده از این روش میتوان درستی اندازهگیریهای تجربی را مورد آزمایش قرار داد. اما آنچه باید در نظر داشت، بهینهسازی هندسهی شبیهسازی جهت دستیابی به نزدیکترین نتایج به شرایط واقعی است. یکی از عواملی که در دقت اندازه گیری نقش دارد نوع آشکارساز است، که بدنه اصلی مطالعهی حاضر را تشکیل میدهد. در شبیهسازی مونت کارلو عموماً از دو تالی آشکارساز نقطهای (F5) و شار حجمی (F4) به منظور برآورد شار فوتون در محل آشکارسازی استفاده می شود [19]

آشکارساز نقطهای (F5) بر آورد شار ذرات در نقطهای از فضا است [۳]، که در محاسبات حفاظ گذاری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین، استفاده از تالی شار حجمی (F4) در سلول معین بدون ماده در محاسبات مونت کارلو متداول است [۲۰]. با این وجود، در نظر گرفتن عواملی همچون ماده، جنس دیواره و پنجره، و ابعاد آشکارساز این سوال را مطرح می کند که آیا تعریف آشکارساز در محاسبات مونت کارلو با تکیه بر مشخصات واقعی ابزار در اندازه گیری تجربی سبب اختلاف نتایج با یافتههای حاضر به دنبال بررسی آشکارساز نقطهای خواهد شد؟ مقالهی حاضر به دنبال بررسی مسالهی مطرح شده با تکیه بر تعریف آشکارساز با مشخصات واقعی و مقایسهی آن با نتایج حاصل از تعریف تالی در

¹ White

² Fano

³ Goldestein & Wilkins

⁴ Berger

⁵ Taylor

⁷ Iteration Method

⁸ Monte Carlo Method

محاسبات مونت کارلو است. از آنجا که شمارندهی گایگر-مولر (GM) و آشکارساز سوسوزن سدیم یدید ((NaI(Tl)) دو ابزار معروف در مطالعات حفاظ هستند، در این پژوهش به بررسی اختلاف ضرایب انباشت حفاظهای فلزی ناشی از تعریف تالی آشکارساز نقطهای، تالی شار حجمی برای سلول بدون ماده، و شبیه سازی شمارنده یگایگر – مولر، و آشکارساز سوسوزن سدیم یدید پرداخته شده است.

۲. فیزیک مسأله

در شرایطی که باریکهای موازی از پرتوهای گاما از مادهای با ضخامت کم عبور کند، تضعیف آن از طریق قانون تضعیف نمایی بیر-لامبرت⁽ که در رابطهی ۱ آمده است، صورت می گیرد.

$$\mathbf{I} = \mathbf{I}_0 e^{-\mu \mathbf{x}} \tag{1}$$

که در آن I۵ شدت پرتو فرودی و I شدت پرتوهای عبور کرده از ضخامت (۳۵) مادهای با ضریب تضعیف خطی (^۱-۳۰) است [٥]. ضریب تضعیف خطی تابعی از انرژی پرتوی گامای فرودی و عدد اتمی ماده است. باید توجه داشت که شرایط فوق تنها در حالت ایدهآل برقرار است و در شرایط واقعی به دلیل برهمکنشهای میان فوتونها و الکترونهای اتمی ماده احتمال رسیدن پرتوهای پراکنده در محیط به نقطهی آشکارسازی وجود دارد [۲۱] که سبب می گردد شمار فوتونهای رسیده به سلول آشکارساز متفاوت از پیشبینی قانون تضعیف نمایی بیر -لامبرت باشد [٤]. در حقیقت، این قانون مادامی معتبر است که پرتوهای گاما تکانرژی باشند، مادهی پراکننده ضخامت بسیار کمی داشته باشد، و پرتوهای فرودی به صورت موازی و باریک تعریف شوند [۲۲]. در مورت عدم برقراری هر یک از این شروط، یک ضریب

تصحیح به نام ضریب انباشت باید در نظر گرفته شود. ضریب انباشت، B (I≤B)، سهم پرتوهای پراکنده را در نظر میگیرد و عبارت است از نسبت کل پرتوهای رسیده به آشکارساز بـه پرتوهایی که بدون پراکندگی به آشکارساز رسیدهاند. رابطـهی ۲ تضعیف پرتوها در این حالت را نشان میدهد.

$$I = I_0 B e^{-\mu x}$$

بنابراین، در حالت اید آل ضریب انباشت دارای کم ترین مقدار و برابر با ۱ است و هر عاملی که بتواند اثر پراکندگی ها در هندسه را کاهش دهد سبب می شود ضریب انباشت به سمت ۱ میل کند. همانطور که اشاره شد، وارد کردن ضریب انباشت به قانون بیر -لامبرت پیش بینی منطقی تضعیف فوتون ها انباشت به قانون بیر و سیدن به نقط می آشکارساز را ممکن در عبور از حفاظ و رسیدن به نقط می آشکارساز را ممکن ساخته است. با این و جود، از مقایسه ی برخی مطالعات تجربی ساخته است. با این و جود، از مقایسه ی برخی مطالعات تجربی هندسه ی اجزای آن بر برآورد ضرایب انباشت فوتون مؤثر است.

شناسایی فوتون بر اساس برهم کنش میان تابش و ماده ی آشکارساز رخ می دهد [۲۵]. پس از ورود پرتوهای گاما (کم تر از ۱/۰۲۲ MeV) به سلول آشکارساز، پراکندگی کامپتون و یا جذب فوتوالکتریک اولین رویدادها خواهند بود. در صورتی که انرژی پرتوها بیش تر از MeV ۲۰۲۲ باشد احتمال وقوع تولید زوج نیز وجود دارد. در تمام این حالتها، الکترونهای پرانرژی (keV~) تولید می شود [٤]. چنان که آبشار الکترونی تولید شده پاسخ آشکارساز را شکل می دهد [۲۵]. به عبارت بهتر، شناسایی فوتونها از طریق انرژی به جا مانده در ماده ی آشکارساز صورت می گیرد که ارتباط مستقیم با عدد اتمی، و اندازهی آن دارد [۲۱].

برد الکترون در بلور سوسوزن آنقدر کوتاه است که میتوان فرض کرد فوتون ها همه ی انرژی خود را در اثر

¹ Beer-Lambert

برهم کنش با ماده به جا می گذارند [٤]. در شمارندهی گایگر – مولر نیز تأثیر حفاظ، پنجره ورودی، و پنجرهی انتهایی سبب پسپراکندگی فوتونها به داخل حجم سلول گاز و افزایش شار فوتون می شود [٢٦].

در بسیاری از مطالعات مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو، از تالی آشکارساز نقطهای (F5) برای بر آورد شار فوتون در مکان موردنظر استفاده می گردد. این تالی بر آوردی نیمه قطعی از مجموع محاسبات تصادفی و تحلیلی است که دقت آماری آن نسبت به تالی شار حجمی (F4) به عنوان بر آوردی کاملا تصادفی از طول مسیر بیش تر است. تالی F5 سریع تر از F4 به دقت قابل قبول می رسد [۱۹].

با توجه به تفاوتهایی که در ثبت شار فوتونها در هر یک از انواع محیطهای آشکارسازی بیان شد، پیشبینی می شود که نوع آشکارساز در برآورد ضرایب انباشت موثر است. از این رو، مطالعهی ضرایب انباشت شار بر اساس روش مونت کارلو در دستور کار پژوهش حاضر قرار گرفت.

۳. محاسبات

۱.۳. هندسهی مساله

محاسبات مونت کارلو با استفاده از ک MCNPX [۷۷] انجام شد. هندسه ی شبیه سازی شده ی مسأله ک ه در شکل ۱ نشان داده شده است، شامل سه بخش اصلی است: (الف) پشمه ی نقطه ای همسانگرد ⁶⁰Co که با انرژی متوسط MeV چشمه ی نقطه ای همسانگرد ⁶⁰Co که با انرژی متوسط IVOV بروی ۱/۲۵۳ در نظر گرفته شد؛ (ب) حفاظ تک لایه از فلزات تنگستن (W)، سرب (Pb)، روی (Zn) و تیتانیوم (Ti) که با ضخامت های Mo -۱ در فاصله ی Zn ۶ از چشمه در نظر فرفته شد تا گستره ای از اعداد اتمی را به منظور مطالعه ی دقیق تر پراکندگی کامپتون مشخص کند، و (ج) آشکارساز که در چهار حالت (۱) استوانه ی خلابا ابعاد "۱×"۱ (cm

۲/۹ cm ۲/۵٤» (۲) شمارنده یگایگر – مولر با طول ۳/۹ cm و شعاع ۸۳ NaI(Tl)، (۳) آشکارساز سوسوزن (NaI(Tl با ابعاد "۲×"۲ (۲۰۸ cm²) (۸۰۱۵)، و (٤) کرهای با شعاع ۱ cm ۱، که در فاصله ی ۲۰ cm از چشمه قرار گرفتهاند در نظر گرفته شد.

ضریب تضعیف خطی برای فلزات از پایگاه دادههای ضریب تضعیف خطی برای فلزات از پایگاه دادههای آزاد (m.f.p) که برابر با معکوس ضریب تضعیف خطی است بهعنوان یک فاکتور مهم در مطالعهی ضریب انباشت برای فوتونهایی با انرژی ۱/۲۵۳ MeV برای هر یک از مواد محاسبه شد.



شکل (۱): هندسهی شبیه سازی شده جهت بررسی اثر انواع آشکارساز در برآورد ضرایب انباشت حفاظهای تنگستن، سرب، روی، و تیتانیوم.

چگالی جرمی، ضریب تضعیف خطی، و مسافت آزاد میانگین در انرژی ۱/۲۵۳ MeV برای فلزاتی که در پژوهش حاضر تعریف شدهاند، در جدول ۱ ارائه شده است.

تيتانيوم	روى	سرب	تنگستن	.1						
(Ti)	(Zn)	(Pb)	(W)	ماده						
22	۳۰	٨٤	٧٢	عدد اتمی						
6 (7	N//N 6			چگالی جرمی						
2/0•1	V/12	11/12	14/10	(g/cm ³)						
	15416.4.5			ضريب تضعيف خطى						
•/177	•/٣٧٥	•/ \22	1/+25	(cm ⁻¹)						
		1 / · · · M		مسافت آزاد میانگین						
2/150	7/771	1/004	•/409	(cm)						

جدول (۱): ضرایب تضعیف خطی و مسافت آزاد میانگین برای گاما با

1/70" MeV

ضریب انباشت را می توان بر اساس سه رهیافت تعداد ذرات، انرژی ذخیره شده، و دز تابش حاصل از آنها به دست آورد [3]. پژوهش حاضر از رهیافت تعداد ذرات استفاده کرد و به محاسبهی ضرایب انباشت شار پرداخت. بر این اساس، بازهی انرژی کل (۱۲۵۳ MeV–۲۰/۱) به صورتی تقسیم بندی شد که طول هر بازه ۲۰/۱ باشد. در نهایت، مقدار ثبت شده برای تالی کل به عنوان شار کل فوتونهای رسیده به نقطهی آشکارسازی و مقدار تالی در بازهی آخر به عنوان شار فوتونهایی که بدون برخورد به نقطهی موردنظر رسیده اند، در نظر گرفته شدند. برخورد محاسبه شدند. به منظور کاهش خطای محاسبات، از کاهش واریانس به روش پنجرههای وزنی^۱ استفاده شد که شرح اجرا و اعتبارسنجی آن در ادامه آمده است.

۲.۳. روش اعمال پنجرههای وزنی

پنجرههای وزنی عموماً در محاسبات مونت کارلو و به منظور کنترل وزن آماری ذرات در طول تاریخچه استفاده می-شوند تا اثربخشی محاسبات را افزایش دهند [۳۰]. در این

روش، برای هر بخش از فضای فاز یک پنجره تعریف می شود

مولد پنجرههای وزنی یک برآورد نسبتاً ساده از اهمیت متوسط ذرات در ناحیهی معین از فضای فاز است و خروجی آن از معکوس نمرهی متوسط تولید شده توسط ذرات فرودی به یک ناحیه به دست میآید [۳۰]. یکی از روش های اعمال پنجرههای وزنی این است که چشمه به صورت حقیقی نگه داشته شود، و چگالی ماده تا مقدار معینی پایین آورده شود تا تعدادی از ذرات ثبت شوند و سپس از وزنهای جدید برای به دست آوردن وزن ذرات در مادهای با چگالی واقعی استفاده میشود [۳۱]. شار ۱۰۰۰ ذرهی گسیل شده از چشمه در (الف) حالتی که وزن ذرات در تمام سلولها یک است و (ب) حالتی که وزن ذرات با استفاده از مولد پنجرههای وزنی تعدیل شده است، در شکل ۲ آمده است.

اثربخشی شبیهسازی مونت کارلو با کمک ضریب شایستگی^۲ (FOM) مشخص می شود که عبارت است از:

$$FOM = \frac{1}{R^2 T}$$
(r)

از آنجا که مربع خطای نسبی (R²) متناسب با معکوس تعداد تاریخچهی ذرات و زمان اجرای برنامه (T) متناسب با تعداد تاریخچه است، اگر برنامه در زمان ثابت اجرا شود واریانس

که دارای حد پایین و حد بالای مشخص برای وزن ذرات است [۲۷]. اگر وزن ذره بیشتر از حد بالای پنجره باشد تکثیر رخ میدهد و به ذراتی با وزن قابل قبول تقسیم میشود و اگر وزن ذره کمتر از حد پایین باشد رولت روسی اتفاق میافتد و ذره یا نابود میشود یا وزن آن افزایش یافته و درون پنجره قرار میگیرد [۲۷و ۳۰]. اهمیت در هر سلول به معنای نمره ی مورد انتظار تولید شده از یک ذره با وزن واحد پس از ورود به آن سلول است [۳۱].

² Figure of Merit

¹ Wight Window

کمتر به معنای FOM بزرگتر و اعتبار بیشتر محاسبات است. برای یک شبیهسازی قابل قبول، ضریب شایستگی FOM باید با افزایش تعداد تاریخچهی ذرات تقریباً ثابت باقی بماند [۳۰].



شکل (۲): شار ۱۰۰۰ ذرهی گسیل شده از چشمه در (الف) حالت اول و (ب) پس از اعمال پنجرههای وزنی برای سرب با ضخامت cm ۵.

همانطور که در نمودار شکل ۳ میتوان دید با اعمال کاهش واریانس به روش پنجرههای وزنی، تغییرات FOM در هر مرحله بهبود مییابد، بهطوری که این ضریب در آخرین مرحله با افزایش تاریخچهی ذرات تقریباً ثابت و قابل قبول است و میتوان ادعا کرد که شبیهسازی از اعتبار لازم برخوردار است.



شکل (۳): منحنی FOM شار فوتون بر حسب تاریخچهی فوتونها.

۳.۳. انتخاب انرژی چشمه

چشمهی پرتوزای Co⁶⁰ با گسیل پرتوهای گاما در دو خط انرژی MeV ۱/۱۷۳ و ۱/۳۳۳ MeV و همچنین انرژی متوسط ۱/۲۵۳ MeV برای محاسبات در نظر گرفته شد. نمودار شکل ٤ نشان میدهد که ضرایب انباشت برای فوتونهایی با انرژی متوسط بین ضرایب انباشت فوتونها با دو خط انرژی دیگر قرار می گیرد. بنابراین، در محاسبات حاضر از فوتونه ایی با انرژی متوسط MeV ۱/۲۵۳ MeV برای مطالعه ی ضرایب انباشت استفاده شد.



شکل (٤): ضریب انباشت برای مقادیر انرژی گاماهای چشمه ^{60}Co .

نتایج حاصل از بر آورد شار ذرات و محاسبهی ضرایب انباشت در بخش ٤ ارائه شده است. به منظور دستیابی به خطای آماری قابل قبول (۰/۰٥> برای تالی F4 و ۰/۰۱> برای تالی F3، هر برنامه برای ^۷۰۱×۱ تاریخچه اجرا شد.

٤. نتايج

اعتبارسنجی محاسبات

در راستای تأیید روش استفاده شده جهت محاسبهی ضرایب انباشت شار، محاسبات برای حفاظ تکلایهی سرب با ضخامتهای m.f.p ۸-۰/۰ و گاماهای تک انرژی با

انـرژیهـای MeV و ۲، ۱/۵، ۱/۲۵، ۱، ۰/۰ انجـام گرفـت. جدول ۲ ضرایب انباشت شار محاسبه شده با اسـتفاده از تـالی F4 برای استوانهی خلا را در مقایسه با مقادیر تئوری [۳۲–۳۲]

جدول (۲): مقایسهی ضرایب انباشت شار میان مطالعهی حاضر* و مطالعات پیشین [۲۳و۳۲–۳۳] برای انرژیهای متفاوت و ضخامتهای مختلف سرب

	انرژی (MeV)										. 1					
	٣			۲	١	/0	١	/ 40			١			•/0		صحامت (mfn)
[٣٣]	[٣٢]	*	[٣٢]	*	[٣٣]	*	[٣٣]	*	[٣٣]	[٣٣]	[٣٢]	*	[٣٣]	[٣٢]	*	(
_	-	1/4787	-	1/٣٤٦	1/23	1/3.5	١/١٦	١/٢٨٠	١/٤٦	-	-	1/727	-	-	1/127	•/٥
1/21	1/23	1/271	1/22	1/217	۱/۷٥	١/٦٤٠	1/29	1/290	١/٧٦	۱/۳۱	١/٣٦	1/288	١/١٨	1/42	1/777	١
\/VV	١/٧١	۱/۷۰۱	١/٧٧	١/٧٥٦	۲/۲۹	2/122	١/٩٦	١/٨٥٦	۲/۲۳	١/٦١	١/٦٩	1/779	1/44	1/42	1/30.	۲
۲/۱۳	۲/۱۳	۲/۱۲۳	۲/۱٦	7/117	۲/۸۲	۲/۷۰٤	۲/٦٥	۲/۱۸۰	۲/٦٤	١/٨٧	1/97	1/979	1/22	1/29	1/271	٣
2/01	۲/٥١	۲/۳٦٩	۲/٥٠	۲/۳٦٨	٣/٣١	٣/٢٨١	۴/٦٧	2/002	4/99	۲/۱۰	۲/۱۸	۲/۱۹۰	۱/۵۳	١/٥٩	1/292	٤
۲/۹۱	2/92	7/97.	۲/۸۹	۲/۷٤٦	-	٣/٥٦٠	-	۲/۸۰۰	-	۲/۳۲	۲/٤۲	۲/۳۸٤	١/٦١	١/٦٨	١/٦٠٠	٥
424	۳/۳۹	٣/٣٨١	۳/۳۰	۳/۳۱۰	-	٣/٧٢٢	-	۳/۱۰۸	-	۲/٥٤	۲/٦٦	۲/٦٢.	١/٦٩	١/٧٦	1/79٣	٦
۳/۸۱	۳/۸۷	۳/۷۹.	4/19	4/714	-	٣/٩٣٦	-	٣/٤٧٤	-	۲/۷٥	۲/۸۸	۲/۸٤١	١/٧٧	١/٨٤	١/٧٧٣	٧
٤/٣٠	٤/٤٣	٤/٣٣١	٤/•١	۴/۹۸۸	-	٤/•١٨	-	۳/۸۷۱	-	۲/۹٦	۳/۰٥	٣/٠٥٨	١/٨٥	1/97	۱/۸۰۱	٨

۲.٤. تغییرات ضریب انباشت شار بر حسب عدد اتمی

احتمال وقوع هر یک از سه برهم کنش اصلی فوتوالکتریک، کامپتون، و تولید زوج برای فوتون با هر ماده را میتوان در سه بازه انرژی توضیح داد. در انرژی های کم، احتمال وقوع اثر فوتوالکتریک بیشتر است چنان که سطح مقطع آن بستگی قوی به عدد اتمی ماده و انرژی پرتوهای فرودی دارد (⁴Z~7 قوی به عدد اتمی ماده و انرژی پرتوهای فرودی دارد (⁴Z~7 ^{7/2}). در انرژی های میانی، احتمال پراکندگی کامپتون با سطح مقطع Z/E~6 افزایش مییابد. با این وجود، افزایش عدد اتمی به مقادیر بالاتر سبب میشود جذب به پراکندگی غلبه کند و احتمال وقوع پراکندگی کامپتون در این شرایط کاهش مییابد. در انرژی های بالاتر، احتمال فرآیند تولید زوج بر اساس سطح مقطع Z²logE~۲ افزایش مییابد [۳۰–۳۷].

فوق، ضریب تضعیف خطی μ به دست می آید که به Z و E وابسته است [٤]. بنابراین، هر چه عدد اتمی ماده بیش تر باشـد احتمال اندرکنش فو تون بیش تر است [۳۸].

$$\mu = \tau + \sigma + \kappa \tag{(1)}$$

همانطور که اشاره شد، برهم کنشهای فوتون با ماده با گسیل فوتونهای ثانویه همراه است که منشأ ایجاد ضریب انباشت به شمار میرود. بنابراین انتظار میرود افزایش سطح مقطع پراکندگی منجر به بزرگ شدن ضریب انباشت پرتوهای گاما شود. شکل ٥ تغییرات ضرایب انباشت بر حسب ضخامت ماده برای چهار عنصر تنگستن، سرب، روی، و تیتانیوم در هر آشکارساز را نشان میدهد. همانطور که میتوان دید ضرایب انباشت برای تنگستن بیشترین و برای تیتانیوم کمترین است. هر چهار عنصر در شکل ۲ نشان داده شده است. میتوان دیـد با این حال، بررسی تغییرات سرب و روی مشخص میکند که برای تنگستن و سرب سطح مقطعها تقریباً مشابه است. اگرچه مقدار ضریب انباشت در ضخامتهای کم برای سرب بیشتر از روی است، افزایش ضخامت تا cm ۰ سبب بیشتر میشود پرتوهای بیشتری در ماده شدن آن برای روی نسبت به سرب میگردد. به منظور درک برهمکنش کنند.



شکل (۵): تغییرات ضریب انباشت شار بر حسب ضخامت ماده برای عناصر W. Zn ،Pb، و Ti برای زمانی که آشکارساز (الف) استوانه بدون ماده، (ب) شارنده گایگر– مولر، (ج) سوسوزن سدیم یدید، و (د) تالی نقطهای باشد.

عناصر فوق، تعداد پرتوهای گاما که بدون پراکندگی از ماده عبور میکنند در برابر پرتوهایی که پس از پراکندگی وارد آشکارساز میشوند کاهش مییابد و ضرایب انباشت بزرگتر میشود.

با توجه به تعریف پراکندگی کامپتون، هر چه زاویهی پراکندگی کوچکتر باشد فوتون گاما انرژی بیشتری را در هر برخورد از دست میدهد و سریعتر جذب ماده میشود. در نتیجه برای تنگستن با کوتاهترین مسافت آزاد میانگین در میان



شکل (٦): ضریب تضعیف جرمی (الف) کل و (ب) کامپتون بر حسب انرژی برای عناصر W، Zn، Pb، و Ti.

$$x(m.f.p) = \frac{x(cm)}{m.f.p(cm)}$$
(0)

که در آن، (x(m.f.p به عنوان ضخامت ماده بر حسب مسافت آزاد میانگین از تقسیم ضخامت هر ماده بر حسب cm بر مسافت آزاد میانگین پرتوها در آن ماده بر حسب cm (جدول ۱) به دست میآید. شکل ۷ تغییرات ضرایب انباشت بر حسب (x(m.f.p) را نشان میدهد.

در واقع، شدت پرتو پس از هر پراکندگی به صورت نمایی کاهش مییابد و هر چه ضخامت ماده بیشتر شود احتمال اندرکنش افزایش مییابد. در ضخامتهای بالا، زمانی که پرتو دستخوش پراکندگی میشود به دلیل پراکندگیهای ثانویه احتمال فرار فوتونها کم میشود. در شکل ۷ مشخص است برای سرب ضرایب انباشت با کمترین شیب افزایش مییابد. برعکس، مسافت آزاد میانگین بزرگ تیتانیوم سبب می گردد ضرایب انباشت نسبت به سرب با سرعت بیشتری افزایش یابد. در ارتباط با تیتانیوم، به روشنی میتوان فهمید که سطح مقطع جذب کمتر احتمال رسیدن پرتوهای عبوری غیرپراکنده به آشکارساز را افزایش داده و موجب ضریب انباشت کوچکتر میشود. از سوی دیگر، مقایسهی ضرایب تضعیف کامپتون و کل نشان میدهد روی در انرژیهای میانی دارای سطح مقطع کامپتون بالاتر نسبت به سرب است و همچنین مسافت آزاد میانگین بزرگتری دارد. بنابراین، با افزایش ضخامت ماده سهم پرتوهای پراکنده برای روی بیشتر شده و در انرژیها میانی ضریب انباشت بزرگتری برای روی در مقایسه با سرب بهدست میآید.

با این وجود، این گونه نیست که افزایش ضخامت ماده به معنای افزایش ضریب انباشت باشد. به منظور بررسی بهتر این موضوع، بهتر است ضخامتها بر حسب مسافت آزادمیانگین در نظر گرفته شوند تا تغییرات ضرایب انباشت بر حسب ضخامت برای تمام مواد قابل مقایسه باشد. برای این منظور از رابطهی ٥ برای تبدیل ضخامت حفاظها از واحد cm به m.f.p استفاده شد.



شکل (۷): تغییرات ضریب انباشت شار بر حسب ضخامت ماده برای عناصر Xn ،Pb ، ۷ و Ti برای زمانی که آشکارساز (الف) استوانه بدون ماده، (ب) شارنده گایگر– مولر، (ج) سوسوزن سدیم یدید و (د) تالی نقطهای باشد.

بیش تر می شود. با این حال، رفت ار ضرایب انباشت در تمام آشکارسازها برای فلزات بررسی شده تقریبا مسیر یکسانی را طی میکند. بررسی تالی نقطهای به عنوان حجم آشکارسازی به عنوان یک تالی کاهش واریانس نتایجی نشان داد که انطباق خوبی با تالی شار حجمی دارد. ۳.٤. تغییرات ضریب انباشت شار بر حسب نوع آشکارساز

با توجه به شکل ۸ تغییر نوع آشکارساز سبب می شود نتایج متفاوتی حاصل گردد. به این صورت که استفاده از تالی شار حجمی در استوانهی بدون ماده به عنوان حجم آشکارسازی مقدار ضرایب انباشت را کوچکتر ارزیابی می-کند اما این مقادیر با افزایش ابعاد و چگالی مادهی سلول آشکارساز در شمارندهی گایگر – مولر و سوسوزن یدید سدیم



شکل (۸): تغییرات ضریب انباشت شار بر حسب ضخامت ماده زمانی که ماده (الف) تنگستن، (ب) سرب، (ج) روی، و (د) تیتانیوم باشد برای آشکارسازهای استوانه بدون ماده، شارنده گایگر – مولر، سوسوزن سدیم یدید، و تالی نقطهای.

واحد زمان به ذراتی که در واحد زمان وارد حجم آشکارساز میشوند بازده آشکارساز نام دارد. هر چه احتمال اندرکنش پرتو با ماده بیشتر شود بازدهی بیشتر میشود. چگالی بیشتر مادهی آشکارساز احتمال اندرکنش را بیشتر میکند و بازده را افزایش میدهد. از آنجا که چگالی جامدات حدود ۱۰۰۰ برابر چگالی گاز است، بازدهی آنها در آشکارسازی پرتوهای گاما بیشتر است.

ذرات بارداری که از ماده میگذرند همواره با الکترونها و هستههای آن محیط برهمکنش کولنی خواهند کرد و چون احتمال برهمکنش برای آنها تقریباً قطعی است بازده ثبت آنها ۱۰۰ درصد است. اما چون تضعیف نمایی برای فوتونها رخ مقایسه ی ضرایب تضعیف جرمی برای شمارنده ی گایگر – مولر و سوسوزن یدید سدیم که در شکل ۹ آمده است نشان می دهد که احتمال فوتوالکتریک برای سوسوزن یدید سدیم بیشتر است و پراکندگی کامپتون با احتمال بزرگتر برای شمارنده گایگر – مولر اتفاق می افتد. از این رو، مقدار انرژی بیشتری در سوسوزن یدید سدیم ثبت می گردد و به همین دلیل مقدار ضریب انباشت محاسبه شده از این طریق بالاتر از مقادیر به دست آمده برای شمارنده گایگر – مولر است. هنگامی که ذره ای وارد آشکارساز می شود با توجه به انرژی ذره، نوع، و اندازه ی آشکارساز ممکن است بدون هیچ برهم کنشی آشکارساز را ترک کند. نسبت ذرات ثبت شده در

میدهد همواره احتمال غیرصفری برای عبور بدون برهم کنش وجود دارد که باعث می شود بازده از ۱۰۰ درصد کم تر شود. در واقع، اختلاف مقادیر ثبت شده در شمارنده ی گایگر – مولر و سوسوزن یدید سدیم را می توان به بازده آنها نسبت داد. در نتیجه، انتظار می رود در نظر گرفتن بازده آنها منجر به مقادیر ثبت شده ی یکسان شود.



خطای محاسبات در روش مونت کارلو از بیشترین اهمیت برخوردار است. همانطور که گفته شد، ضریب انباشت از نسبت کل پرتوهای رسیده به آشکارساز (I_t) به پرتوهایی است که بدون پراکندگی به آشکارساز رسیدهاند (I_u) به دست

میآید. رابطهی انتشار خطا [٤] برای ارزیابی خطای محاسبات استفاده شد. بنابراین، خطای نسبی محاسبات عبارت است از:

$$\frac{\sigma_{\rm B}}{\rm B} = \sqrt{\left(\frac{\partial \rm B}{\partial \rm I_t} \sigma_{\rm I_t}\right)^2 + \left(\frac{\partial \rm B}{\partial \rm I_u} \sigma_{\rm I_u}\right)^2} \tag{(7)}$$

که با محاسبهی مشتقات جزئی از نسبت I_t به I_u رابطهی ۷ برای خطای نسبی حاصل می شود.

$$\frac{\sigma_{\rm B}}{\rm B} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{\rm I_t}}{\rm I_t}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\rm I_n}}{\rm I_n}\right)^2} \tag{V}$$

ضرایب انباشت برای ضخامتهای مختلف ماده هم بر حسب cm و هم بر اساس مسافت آزاد میانگین عناصر به همراه خطای نسبی در جدول ۳ آمده است که مقدار کمتر از ۰/۰۵ دال بر اعتبار نتایج به دست آمده است.

٥. نتيجه گيري

ضرایب انباشت شار حاصل از پرتوهای گامای گسیل شده از چشمه نقطهای همسانگرد CO⁶⁰ با انرژی متوسط ۱/۲۵۳ MeV در مواد تنگستن، سرب، روی، و تیتانیوم بهعنوان حفاظ محاسبه شد. از روش مونت کارلو و اعمال کاهش واریانس توسط کد MCNPX برای محاسبات استفاده شد. نتایج را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

- روش کاهش واریانس پنجرههای وزنی سهم مهمی در کهش زمان محاسبات و نتایج دقیقتر بهویژه در ضخامتهای بالاتر دارد. روش استفاده شده که مبتنی بر کاهش چگالی ماده تا رسیدن به وزن مناسب ذرات بود مؤثر ارزیابی شد.

 ضرایب انباشت به عدد اتمی ماده بستگی دارد و با توجه به ضرایب تضعیف جرمی برای فوتونها با انرژی معین در ماده میتوان رفتار پرتوها در عبور از مواد حفاظ را پیشبینی کرد.

- نوع آشکارساز تعریف شده در محاسبات بر ضرایب انباشت محاسبه شده تأثیر دارد به طوری که برای شار حجمی بدون تعریف ماده و شار نقطهای مقادیر مشابهی به دست آمد اما این مقادیر با افزایش چگالی مادهی آشکارساز در تعریف شمارنده گایگر – مولر و سوسوزن سدیم یدید افزایش یافت. با این حال، با توجه به سهم بازده آشکارساز به نظر میرسد اعمال این کمیت منجر به کسب مقادیر یکسان برای پرتوهای ثبت شده در انواع آشکارساز شود.

		و خطای محاسبات.	ل (۳): نتایج شبیهسازی	جدو					
		ضخامت	ضخامت	,					
سدیم یدید آشکارساز نقطهای		گايگر – مولر	استوانه بدون ماده	-	(m.f.p)	(cm)	مواد		
¥/+VV	١/٦٤٧	1/044	1/079	В					
•/••0	•/•11	•/••1	•/••٦	σ_B/B	1/+21	,			
۲/٦٦٧	۲/•٩٦	۲/• ۲٤	۲/۰۱۳	В					
•/•١١	•/•1٣	•/•••	•/••٩	σ_B/B	٩/٠٨٥	۲			
4/174	۲/٤٩١	7/27.	2/242	В					
•/•11	•/•1¥	•/••٣	•/•1٣	σ_B/B	4/114	۴	تنگستن (W)		
4/1.1	۲/۸۰۹	۲/۷۸٤	Y/VVA	В					
•/•1٦	•/•٢•	•/••0	•/• \V	σ_B/B	٤/١٧١	٤			
٤/•٧٧	*/**•	3/132	٣/١٦٨	В					
• / • ١٣	•/•٢٥	•/••٧	•/•*1	σ_B/B	0/114	٥			
1/191	١/٤٠٧	1/828	1/424	В					
•/••٣	•/••٨	•/••1	•/••٣	σ_B/B	•/٦٤٤	`			
1/110	١/٦٦٨	1/2.1	١/٥٩٨	В					
•/••0	•/•11	•/•••	•/••£	$\sigma_{\rm B}/{\rm B}$	1/744	۲			
1/110	۲/ • ۲٥	1/870	1/413	В					
•/••٨	•/•18	•/••₹	•/••0	σβ/Β	1/944	٣	سرب (Pb)		
۲/٦٥٥	۲/۱۰۸	۲/۰۲۹	۲/۰۲۳	В					
•/••¥	•/•1٦	•/••٣	•/•11	σ.,/Β	Y/OVV	٤			
۲/۸۹۳	1/101	۲/۲۲.	*/***	B					
•/••V	•/•1٨	•/••£	•/•1٣	σ _n /B	4/11/	٥			
1/114	1/177	1/3.1	1/201	B B	•/ * V٤				
•/••٣	•/••٦	•/••1	•/••٦	σ _n /B		١			
Y/+ 7V	١/٦٨٩	1/7114	1/344	B B	•/٧٤٩				
•/••٣	•/••٨	•/••1	•/••٨	σ _p /R		۲			
Y/21V	۲/۰۰۲	1/977	1/977	B B	1/172				
•/••0	•/••٩	•/•• •	•/••٨	σ/B		٣	روی (Zn)		
7/V34	Y/#Y3	۲/۲٤٣	Y/YYY	B					
•/••٦	•/•))	•/•• •	•/••٨	σ/P	1/299	٤			
٣/١٤٢	1/201	Y/0V.	Y/0V9	UB/D					
•/••٦	•/•14	•/•••	•/•••	р - /Р	1/445	٥			
1/011	1/124	1/140	1/105	OB/B					
•/••¥	•/••٦	•/•••	•/••*	в - /D	•/٣٣٦	١			
1/4+1	1/550	1/201	1/202	UB/D					
•/••¥	·/···V	•/•••	•/••5	в - /D	•/٤٧٢	۲			
*/	1/755	1/024) (OYA	OB/B					
• / • • *	•/•••		u ۱/۰۰۶ – ۲۰	в	•/٧•٨	٣	تيتانيوم (Ti)		
Y / Y V J	\/^\$^	1/2/3	\/\\\{	σ _B /B R					
./		./	./	. /ъ	•/922	٤			
•/••Z	۰/۲۳٦ س. سم			σ _B /B					
1/257	1/*17	1/477	1/972	В	1/18•	٥			
•/••0	•/•11	•/••1	•/••0	σ_B/B					

٦. مراجع

- T. Sandev. Monte carlo simulation of buildup factors for single and multi-layer shields by using penelope code, Proceedings of the Second Conference on Medical Physics and Biomedical Engineering, Munich, Germany, (2010).
- [2] H. Kharrati, A. Agrebi and M.K. Karaoui. Monte carlo simulation of x-ray buildup factors of lead and its applications in shielding of diagnostic x-ray facilities. Med. Phys. 34 (2007) 1398–1404.
- [3] M.K. Karoui and H. Kharratia. Monte carlo simulation of photon buildup factors for shielding materials in radiotherapy x-ray facilities. Med. Phys. 40 (2013) 073901–13.
- [4] N. Tsoulfanidis. Measurement and detection of radiation. 3rd Edition, Taylor & Francis, (2010).
- [5] K. Shina and H. Hirayama. Calculation of gammaray buildup factors for two-layered shields made of water, concrete and iron and application of approximating formula. Radiat. Phys. Chem. 61 (2001) 583–584.
- [6] L.A. Al-Ani, L.E. Goarge and M.S. Mahdi. Gamma ray buildup factor for finite media in energy range (4-10) MeV for Al and Pb. J. Al-Nahrain University. 18 (2015) 88–95.
- [7] P. Deatanyah. Determination of photon ambient dose buildup factors for radiological applications for points and plaque source configurations using MCNP5. Int. J. Sci. Tech. 1 (2011) 174–178.
- [8] L. Musilek, T. Cechak and F. Seda. The use of the Monte Carlo method for the calculation of build-up factors in wide conical gamma-radiation beams. Nucl. Instr. Meth. 174 (1980) 565–569.
- [9] V.P. Singh and M.N. Badiger. Comprehensive study of energy absorption and exposure build-up factors for concrete shielding in photon energy range 0.015–15 MeV up to 40 mfp penetration depth: dependency of density, chemical elements, photon energy. Int. J. Nucl. Energy. Sci. Tech. 7 (2012) 75–99.
- [10] M. Kurudirek. Gamma-ray energy absorption and exposure buildup factor studies in some human tissues with endometriosis. Appl. Radiat. Isot. 69 (2011) 381–388.
- [11] S. Singh, A. Kumar, C. Singh, K. Singh Thind and G.S. Mudahar. Effect of finite sample dimensions and total scatter acceptance angle on the gamma ray buildup factor. Ann. Nucl. Energy. 35 (2008) 2414– 2416.
- [12] C. Garrett and G.N. Whyte. Buildup measurements on cobalt-60 gamma radiation in iron and lead. Phys. Rev. 95 (1954) 889–891.

- [13] M.J. Berger and L.V. Spencer. Penetration of gamma rays from isotropic sources through aluminum and concrete, NBS Tech. Note 11 (1959).
- [14] J.J. Taylor. Application of gamma ray buildup data to shield design, WAPD-RM-217 (1954).
- [15] Y. Harima. An Approximation of Gamma-Ray Buildup Factors by Modified Geometric Progression. Nucl. Sci. Eng. 83 (1986) 299–309.
- [16] J.M. Sharaf and H. Saleh. Gamma-ray energy buildup factor calculations and shielding effects of some, Jordanian building structures. Radiat. Phys. Chem. 110 (2015) 87–95.
- [17] C. Suteau and M. Chiron. An iterative method for calculating gamma-ray buildup factor in multilayers shields. Radiat. Prot. Dosimetry. 116 (2005) 489–492.
- [18] D. Sandari, A. Abbaspour, S. Baradaran and F. Babapour. Estimation f gamma and X-ray Photon buildup factor in soft tissue with monte carlo method. Appl. Radiat. Isot. 67 (2009) 1438–1440.
- [19] J.J. DeMarco and R.E. Wallace, K. Boedeker. An analysis of MCNP cross-sections and tally methods for low-energy photon emitters. Phys. Medicine. Biology. 47 (2002) 1321–27.
- [20] J.F. Briesmeister. MCNP- A general Monte Carlo N-particle transport code, version 4C, Los Alamos National Laboratory, LosAlamos, Report No. LA-13709-M, (2000).
- [21] H. Hirayama and Y. Harima. Detailed behavior of exposure buildup factor in stratified shields for plane-normal and point isotropic sources, including the effects of bremsstrahlung and fluorescent radiation. Nucl. Sci. Eng. 113 (1993) 367–378.
- [22] V.P. Singh and N.M. Badiger. A comprehensivestudy on gamma-ray exposure buildup factors and fast neutron removal cross sections of fly-ashbricks, J. Ceramics. (2013)Article ID 967264.
- [23] M.J.R. Aldhuhaibat, M.K. Alfakhar, and M.S. Amana. Numerical buildup factor calculation of gamma rays for single, dual, and multi-layers shields using lead and aluminum. IJRSP. 6 (2015) 5184–5189.
- [24] M.S. Al-Arif and D.O. Kakil. Calculated Experimental Model for Multilayer Shield, 3 (2015) 23–27.
- [25] M. Kai. Alpha-, Beta- and Gamma-Ray Spectroscopy, Elsevier, (1981).
- [26] I. Meric, G.A. Johansen, M.B. Holstad and R.P. Gardner. Nuclear monte carlo modelling of gammaray stopping efficiencies of Geiger–Muller

counters. Inst. Meth. Phys. Res. A. 636 (2011) 61-66.

- [27] D.B. Pelowitz. MCNPX user's manual, Version 2.6, Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, (2008).
- [28] H. Tavakli-Anbaran, H. Miri-Hakimabad and R. Izadi-Najafabadi. Effects of the detector-collimator on the gamma-rays response function for a NaI(Tl) detector in a constant time of counts. J. App. Sci. 9 (2009) 1550–1555.
- [29] L. Geward, N. Guilbert, K. Jensen and H. Levring. WinXCom- a program for calculating X-ray attenuation coefficients. Radiat. Phys. Chem. 71 (2004) 653–654.
- [30] J.E. Hoogenboom and D. Legrady. A critical review of the weight window generator in MCNP, American Nuclear Society, on CD-ROM, (2005).
- [31] T.E. Booth. MCNP Variance Reduction Examples, Los Alamos National Laboratory, (2005).
- [32] U.T. Lin and S.H. Jiang. A dedicated empirical formula for γ -ray buildup factors for a point isotropic source in stratified shields, Radiat. Phys. Chem. 48 (1996) 389–401.
- [33] ANSI/ANS, gamma-ray attenuation coefficient and buildup factors for engineering materials.

ANSI/ANS-6.4.3-1991. American Nuclear Society, La Grange, (1991).

- [34] A. Shimizu, T. Onda and Y. Sakamoto. Calculationof gamma-ray buildup factors up to depths of 100 mfp by method of invariant embedding (III), J.Nucl. Sci. and Tech, 41 (2004) 413–424.
- [35] B. Oto, S.E. Gulebaglanand G.S. Kanberoglu. Thecalculation of some gamma shielding parametersfor semiconductor CsPbBr3, J. Appl. Phys. 1815 (2017) 130008 (1-4).
- [36] M. Dong, B.O. Elbashir and M.I. Sayyed. Enhancement of gamma ray shielding properties by PbO partial replacement of WO₃ in ternary 60TeO₂-(40-x)WO₃-xPbO glass system, Chalcogenide Lett. 14 (2017) 113–118.
- [37] V.P. Singh, N.M. Badiger and N. Kucuk. Assessment of methods for estimation of effective atomic numbers of common human organ and tissue substitutes: waxes, plastics and polymers, Radioprotection, 49 (2014) 115–121.
- [38] P. Kaur, D. Singh and T. Singh. Heavy metal oxide glasses as gamma rays shielding material, Nucl. Eng. Des. 307 (2016) 364–376.